ДИНАМИКА РЕШЕТКИ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

УДК 548.73

Посвящается памяти Б.К. Вайнштейна

К ВОПРОСУ О "КОЛОССАЛЬНОМ" МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ

© 2011 г. С.А. Пикин

Институт кристаллографии РАН, Москва E-mail: pikin@ns.crys.ras.ru Поступила в редакцию 02.02.2011 г.

В связи с недавними экспериментами на манганитах в настоящей работе в рамках теории Ландау показано, что магнитоэлектрический эффект возникает при приложении критического магнитного поля. Знаки константы спин-орбитального взаимодействия и волнового числа спирали взаимосвязаны. Спиральная структура и слабый ферромагнетизм образуются одновременно в результате фазового перехода первого рода при критической температуре, которая зависит от магнитного поля, причем температурная область эффекта расширяется с возрастанием поля. В этой области температур магнитный момент возрастает, а поправка к электрической поляризации, являясь отрицательной, также увеличивается по абсолютной величине с ростом магнитного поля выше его порогового значения. Эти изменения непосредственно связаны с ростом волнового числа спирали при уменьшении температуры ниже точки фазового перехода.

ВВЕДЕНИЕ

В [1] обсуждается гипотетическая возможность значительного магнитоэлектрического эффекта. Автор опирается на эксперименты [2], где изучалось магнитоэлектрическое поведение лантанидов $Eu_{0.75}Y_{0.25}MnO_3$ (орторомбически искаженная структура перовскита). Теоретической предпосылкой в [1] явилось феноменологическое выражение, в котором сегнетоэлектрическая поляризация **Р** и поперечная спираль индивидуальных спинов **S**_i стабилизируют друг друга благодаря взаимодействию

$$\lambda \mathbf{P}((\mathbf{S}_{i} \times \mathbf{S}_{i+1}) \times \mathbf{q}) \equiv$$

$$\equiv \lambda P_{x}(S_{i+1,x} \partial S_{i,y} / \partial y - S_{i+1,y} \partial S_{i,x} / \partial y)$$
(1)

или

$$\mathbf{D}_{i, i+1}(\mathbf{S}_{i} \times \mathbf{S}_{i+1}) \equiv D_{i, i+1, z}(S_{i, x}S_{i+1, y} - S_{i, y}S_{i+1, x}), \quad (2)$$

где $\mathbf{D}_{i,i+1}$ – вектор Дзялошинского—Мория (Д**M**) [3, 4], который пропорционален псевдоскалярному параметру спин-орбитального спаривания λ [3] и смещению **u** атома кислорода между соседними Mn³⁺ ионами (рис. 1) [4, 5]:

$$\mathbf{D}_{i,\,i+1} = \lambda(\mathbf{u} \times \mathbf{r}_{i,\,i+1}), \quad D_{i,\,i+1,\,z} = \lambda(u_x r_{i,\,i+1}). \quad (3)$$

Лиганды кислорода посредничают в обмене между спинами ионов переходных металлов, обеспечивая связи между ними. Вектор ДМ одинаков для всех пар соседних ионов и меняет знак при инверсии всех координат, включая координаты спинов, как и векторное произведение ($S_i \times S_{i+1}$). При этом отрицательно заряженные ато-

мы кислорода О²⁻ когерентно смещаются (выталкиваются взаимодействием ДМ) от упомянутой спирали по направлению оси y(b), образованной спинами ионов марганца, индуцируя электрическую поляризацию перпендикулярно ее оси (рис. 1). Взаимодействие ДМ увеличивает эти смещения, изменяя степень инверсионной симметрии, которая нарушается в местах нахождения кислорода [6]. Другим конкурирующим фактором является слабый ферромагнетизм вдоль легкой оси z(c), причем магнитный момент также пропорционален спин-орбитальному взаимодействию λ. Вектор ДМ в такой конфигурации меняет свой знак между парами спинов вдоль оси z. При действии достаточно сильного магнитного поля, преодолевающего магнитную анизотропию, вдоль этой оси возникает еще больший магнитный момент за счет разориентации спинов в плоскостях ду на малый угол (рис. 1).

В [2] спираль магнитных спинов располагалась в легкой *xy*(*ab*)-плоскости перовскита, генерируя отрицательную поправку *p* к положительной сегнетоэлектрической поляризации *P_s* вдоль оси *x*(*a*). Этот эффект возникает только в магнитном поле **H** || *z*(*c*) сильнее 5.5 Тл при температурах ниже 20 К. При более высокой температуре поправка *p* обращается в нуль, и магнитная спираль исчезает. Эффект заключается в том, что достаточно большое поле **H** || *z*(*c*) увеличивало намагниченность $\Delta m_z = m_z - \chi_m H \equiv \mu$ в некоторой области температур ΔT при существовании спонтанной сегнетоэлектрической поляризации **P**_s || **x**(*a*) ниже точки



Рис. 1. Качественная картина магнитоэлектрического эффекта (по мотивам [5–7]). Схематически показаны: спиральная структура спинов ионов марганца (темные кружки) в плоскости *ху* вдоль оси *y*; однородные смещения ионов кислорода (светлые кружки) от оси спирали, вызывающие возникновение вдоль оси *x* однородной поляризации **p**, противоположной по направлению к уже существующей спонтанной поляризации **P**_s при наличии магнитного поля **H** вдоль оси *z*.

перехода в сегнетофазу $T_{FE} \approx 30$ К. В интервале ΔT одновременно наблюдалось существенное понижение поляризации Px из-за отрицательности p. В этой же области температур приложение электрического поля Е || $\mathbf{x}(a)$ (~10 кВ/см) приводило к уменьшению Δm_z на 50% и увеличению P_x . Приложение магнитного поля H несколько расширяло температурный интервал ΔT , где имело место такое влияние поля H на поляризацию P_x и намагниченность μ . Кроме того, явление имело ярко выраженный гистерезисный характер. Для таких материалов характерно стеклообразное поведение [2].

Различные аспекты микроскопических механизмов индуцирования сегнетоэлектричества в магнитных спиралях, а также феноменологических подходов обсуждались в [7–11]. В настоящей работе предлагается феноменологическая версия явлений, перечисленных в [2], которая непротиворечиво объясняет наблюдаемые факты.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПИРАЛЬНОЙ СПИНОВОЙ СТРУКТУРЫ

Для описания указанных свойств таких перовскитов применим простую феноменологическую модель, учитывающую основные параметры этих материалов. Будем предполагать, что в рассматриваемом температурном интервале существует спонтанная поляризация P_s. Предположим также, что при некоторых условиях может возникать слабый ферромагнетизм с намагниченностью µ, если существует модуляция магнитной структуры в легкой ху-плоскости, а поле Н превышает определенное пороговое значение H_{th} . Пороговое значение H_{th} зависит от магнитной анизотропии. На рис. 1 дан пример модуляции ферромагнитного состояния вдоль оси у: θ – модулированный угол между соседними спинами S_i и S_{i+1} , причем $\theta^2 \ll 1$, x- и y-компоненты этих спинов суть S_{ix} = $= S \sin \varphi, \ S_{iy} = S \cos \varphi, \ S_{i+1,x} = S \sin(\varphi - \theta), \ S_{i+1,y} =$

= $S \cos(\varphi - \theta)$, те. угол между ними слабо изменяется, хотя сами спины могут поворачиваться в плоскости *xy* на большой угол φ . При этом ($\mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_{i+1}$)_z = $S^2 \sin \theta \approx S^2 \theta$ для любого значения φ , где S – спин. Если спины образуют спираль в плоскости *xy* с волновым вектором q_y вдоль оси спирали ($\varphi = q_y y$), то величина $\theta(y)$ остается постоянной и примерно равной малому углу $\theta =$ $= q_y r_{i,i+1}$. Заметим, что инвариант (2), в согласии с (3), принимает вид $\lambda r_{i,i+1}^2 S^2 u_x q_y$.

Допустим, что вплоть до точки замерзания $T_f < T_{FE}$ спиральная модуляция не появляется при $T < T_{FE}$, если не учитывать магнитоэлектрический эффект. Согласно [2], ниже температуры замерзания $T_f \sim 10$ К кинетика перехода первого рода в спиральное и слабоферромагнитное состояние замедляется благодаря замораживанию беспорядка в образующемся магнитоэлектрическом стекле, а выше T_f — такое стекло плавится, и в магнитном поле генерируется магнитный момент слабого ферромагнетика.

Рассмотрим число $Q = S^2 q_y$ в качестве параметра перехода, который отвечает также за возникновение спиральной структуры и слабого ферромагнетизма. Учтем существование магнитоэлектрического эффекта и запишем свободную энергию в виде

$$F = t_1 P_s^2 + \frac{1}{2} b_1 P_s^4 + 2b_1 P_s p_x^3 + \frac{1}{2} b_1 p_x^4 + \frac{1}{2} b Q^4 + \frac{1}{2\gamma_{e0}} p_x^2 + t_2 Q^2 + \Lambda Q p_x.$$
(4)

Здесь полная поляризация $P_x = P_s + p_x$, $t_1 = a_1(T - T_1), t_2 = a(T - T_2), T_1 \equiv T_{FE}, T_2$ – температура перехода в модулированное состояние. Разложение проводится по малым однородным величинам p_x и $Q = S^2 q_y$, которые надо определить. Коэффициенты $a, a_1, b, b_1, \chi_{e0}$ (диэлектрическая восприимчивость) положительны. Положительно определенный инвариант типа $p_x^2 Q^2$ для простоты не включен в (4), поскольку он сходен с другими членами того же порядка и качественно не изменяет результатов. Последний член в выражении (4) описывает магнитоэлектрический эффект, причем векторы поляризации **р** и \mathbf{P}_{s} параллельны оси $\mathbf{x}(a)$ и разнонаправленны (как убедимся ниже), вектор ($\mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_{i+1}$) параллелен оси $\mathbf{z}(c)$, спиральная модуляция спинов происходит вдоль оси y(b) с волновым вектором **q** в цепочке. Согласно (1), величина $\Lambda Q p_x \equiv \lambda p_x (S_{i+1,x} \partial S_{i,y} / \partial y - \lambda p_x)$ $-S_{i+1} \partial S_{i,x} / \partial y$) не меняет знака при инверсии координат, причем знак Λ остается неизменным при инверсии координат, а $|\Lambda| \equiv |\lambda|$. В (4) можно было бы включить инвариант $c\Lambda \varsigma_x Q^3$, в котором знак постоянной *c* не определен. Соответствующий инвариант типа $(\lambda \zeta_x)(S_{i+1,x}\partial S_{i,y}/\partial y - S_{i+1,y}\partial S_{i,x}/\partial y)^3 \sim$ $\sim (\Lambda \zeta_x) Q^3$ не меняет знака при инверсии координат. Но он является малой поправкой к последнему члену в (4). Векторы $\zeta \parallel x$ и разность намагниченностей L || у двух подрешеток определяют спонтанную намагниченность слабого ферромагнетика $\mathbf{\mu} \parallel z, \mathbf{\mu} = \chi_m H_D$, обусловленную полем Дзялошинского $H_D = |\varsigma| L$, где χ_m – магнитная восприимчивость, |ζ| – малая величина релятивистской природы [12].

В отсутствие магнитного поля параметр t_2 является, по-видимому, положительным: обычно $T > T_2$. Он характеризует своеобразную упругую гибкость магнитной цепочки вдоль оси у, т.е. способность к поворотам марганцево-кислородных бипирамид и изгибу плоскостей редкая землякислород в присутствии небольших редкоземельных немагнитных ионов Еи и Ү, находящихся между октаэдрами MnO₆ в составе орторомбических манганитов [9, 10]. Чем меньше размер подобных ионов, тем сильнее фрустрация магнитной структуры, т.е. возможность ее модуляций [5, 11]. Присутствие в структуре других, более крупных лантанидов увеличивает упругость t₂ и может сделать невозможным существование модулированной магнитной структуры и магнитоэлектрического эффекта при данной константе спин-орбитального взаимодействия λ ионов Mn³⁺ [5]. Таким образом, «модуль упругости» t_2 может существенно изменяться в зависимости от состава манганита.

При данных условиях запишем:

$$p_x \equiv p, \quad P_x = P_s + p, \quad Q = S^2 q_y. \tag{5}$$

Несложный расчет показывает, что такая однородная поляризация **р** минимизирует свободную энергию *F*, если

$$p \approx -\chi_{e0} \Lambda Q.$$
 (6)

10 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 56 № 4 2011

При этом в (4) пренебрегли малыми величинами q и p в степени выше второй. Заметим, что знак поправки p зависит от знака волнового числа спирали q_y . Согласно (6), при инверсии координат изменяется на противоположный и знак вектора **p**, т.е. знаки векторов поляризации **P**_s и **p** остаются противоположными (рис. 1).

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРВОГО РОДА В СПИРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Изменение свободной энергии, согласно выражениям (4) и (6), записывается в виде

$$F = t_1 P_s^2 + \frac{1}{2} b_1 P_s^4 + 2b_1 P_s p^3 + \frac{1}{2} b Q^4 + \frac{1}{2} b_1 p^4 + \tilde{t}_2 Q^2,$$
(7)
где

$$\tilde{t}_2 \approx t_2 - \frac{1}{2} \chi_{e0} \Lambda^2.$$
(8)

Последний член в (7) показывает, что температура перехода в спиральную структуру могла бы повыситься до величины

$$\tilde{T}_2 = T_2 + \frac{\chi_{e0}\Lambda^2}{2a},\tag{9}$$

что может способствовать возникновению такого состояния при $\tilde{t}_2 < 0$. Однако температура фазового перехода \tilde{T}_{2c} с учетом этих поправок должна быть больше температуры замерзания T_{f} , что отнюдь не очевидно (рис. 2).

В противном случае рассматриваемая спиновая модуляция и электрическая поляризация не могут возникнуть.

Перепишем выражение для свободной энергии (7) в виде:

$$F = -\frac{t_1^2}{2b_1} + \tilde{t}_2 Q^2 - b_2 Q^3 + \frac{1}{2} B Q^4, \qquad (10)$$

которое учитывает зависимость

p =

$$-\Lambda \chi_{e0} Q^+. \tag{11}$$

Из (10) следует, что происходит фазовый переход первого рода по параметру Q (волновому числу):

$$Q^{+} = \frac{3b_2 + \sqrt{9b_2^{\ 2} - 16B\tilde{t}_2}}{4B},$$
 (12)

где

$$b_2 = 2b_1 P_s (\Lambda \chi_{e0})^3, \quad B = [b + b_1 (\chi_{e0} \Lambda)^4].$$
 (13)

Точка этого перехода есть

$$\tilde{t}_{2c} = \frac{b_2^2}{2B}, \quad \tilde{T}_{2c} = T_2 + \frac{\chi_{e0}\Lambda^2}{2a} + \frac{b_2^2}{2aB},$$
 (14)

в которой Q претерпевает скачок от нуля к значе-

нию $Q_c^+ = b_2/B$. Вообще говоря, данная спиральная структура может быть несоразмерной и длиннопериодической в силу малости отношения



Рис. 2. Одновременное появление однородной поляризации p(T) и магнитного момента $\mu(T)$ при наличии спонтанной поляризации $P_s(T)$ в температурном интервале от $T_f \, \Delta o \, \tilde{T}_{2Hc}$. Условно, для сравнения с результатами [2], показаны: зависимости $P_x(T)$ и $\mu(T)$ при появлении спиновой спирали и при возрастании магнитного поля (1, 2, 3), превышающего пороговое значение; температуры сегнетоэлектрического перехода T_1 и гипотетического образования спирали \tilde{T}_{2c} ниже точки замерзания T_f .

 b_2/B . Также скачком изменяется в этой точке и поляризация $P_{xc} = P_s - \Lambda \chi_{e0} Q_c^+$, выше температуры \tilde{T}_{2c} имеем параэлектрическую фазу в смысле поправки к поляризации *p*.

Ранее неявно предполагалось, что параметр Λ положителен. Если он отрицателен, т.е. $\Lambda < 0$, то коэффициент b_2 в (10), согласно (13), меняет знак и вместо (12) решением является волновое число

$$Q^{-} = \frac{3b_2 - \sqrt{9b_2^{\ 2} - 16B\tilde{t}_2}}{4B} < 0.$$
(15)

Таким образом, фактически знак спирали (знак волнового числа q_y) изменяется на противоположный, так что из (6) следует неизменность знака поляризации *p* при $\Lambda < 0$. В точке перехода (14) скачок $Q_c^- = b_2/B$ становится отрицательным, а поляризация *p* претерпевает тот же отрицательный скачок $-\Lambda \chi_{e0} Q_c^-$. Сделанные приближения верны, когда поправка *p* много меньше P_s . На опыте в слабых магнитных полях эта поправка весьма мала, и этот фазовый переход не происходит выше точки замерзания, если поле не превышает определенный порог [2].

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЛАБОГО ФЕРРОМАГНЕТИЗМА И МАЛОЙ ПОПРАВКИ К СПОНТАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Приведенные выше результаты были получены в отсутствие магнитного поля, когда, по-видимому, $\tilde{t}_2 > 0$. Возникновение слабого ферромагнетизма и магнитного момента μ (m_z за вычетом обычной величины $\chi_{m0}H$) вдоль оси z в магнитном поле Н можно связать с разрушением антиферромагнитного порядка вдоль этой оси. Учтем то обстоятельство, что на опыте слабый ферромагнетизм возникает одновременно со спиральной спиновой структурой, причем это приводит к пороговому появлению намагниченности µ и поляризации *p* при $H^2 > H_{th}^2$ [2]. Видимо, пороговое магнитное поле разрушает синусоидальное модулирование намагниченности вдоль оси у, чему соответствует параэлектрическое состояние по отношению к поправке р с сохранением спонтанной поляризации P_s [5, 6]. Механизмы такого разрушения могут быть различны: либо вследствие преодоления магнитной анизотропии, либо механических напряжений, возникающих благодаря магнитострикции [6, 11]. При более низкой температуре энергетически более выгодным становится спиральное магнитное упорядочение в плоскости ху, сопровождаемое сегнетоэлектрическим упорядочением по отношению к р (рис. 1).

Запишем свободную энергию *F_H* в простейшем виде:

$$F_{H} = F + \frac{m^{2}}{2\chi_{m}} - mH = -\frac{1}{2}\chi_{m}H^{2},$$
(16)

 $m = \chi_m H = (\chi_{m0} + \delta \chi_m) H, \quad \mu = (\delta \chi_m) H,$ где малая поправка к магнитной восприимчиво-

где малая поправка к магнитной восприимчивости $\delta \chi_m$, связанная с появлением модуляции отклонений спинов в плоскости *ху*, записывается в виде

$$\delta \chi_m = \left(\beta Q^2\right),\tag{17}$$

параметр В положителен. Из (16) и (17) находим

$$F_H = F - \left(\beta Q^2\right) H^2.$$
(18)

Выражение (18) показывает, что фактически в формуле (4) приведенная температура t_2 заменяется на $t_2 - \beta H^2$. Когда магнитное поле становится достаточно большим: $H \ge H_{th}$, например, магнитная энергия в поле начинает превышать энергию магнитной анизотропии, величина $t_2 - \beta H^2$ может стать отрицательной, причем намагниченность $\mu \sim \delta \chi_m (H - H_{th})$ мала вблизи этого порога.

Таким образом, из-за присутствия магнитного поля в выражении (7) эффективно изменяется

коэффициент при степени Q^2 и вместо (10) получаем выражения

$$F_{H} = -\frac{t_{1}^{2}}{2b_{1}} + \tilde{t}_{2H}Q^{2} - b_{2}Q^{3} + \frac{1}{2}BQ^{4},$$

$$\tilde{t}_{2H} = \tilde{t}_{2} - \beta H^{2}.$$
(19)

Теперь с помощью уравнений (7), (10)–(14) и (19) определяем величины волнового числа Q_H , поправки к поляризации p_H и магнитного момента μ :

$$Q_{H} = \frac{3b_{2} + \sqrt{9b_{2}^{2} - 16B(\tilde{t}_{2} - \beta H^{2})})}{4B},$$
 (20)

$$p_{H} = -\Lambda \chi_{e0} \frac{3b_{2} + \sqrt{9b_{2}^{2} - 16B(\tilde{t}_{2} - \beta H^{2})}}{4B}, \qquad (21)$$

$$\mu = \left(\beta Q_{H}^{2}\right)(H - H_{th}) =$$

$$= \beta (H - H_{th}) \left[\frac{3b_{2} + \sqrt{9b_{2}^{2} - 16B(\tilde{t}_{2} - \beta H^{2})}}{4B}\right]^{2}.$$
(22)

Уравнения (21) и (22) гласят, что при значении приведенной температуры

$$\tilde{t}_{2Hc} = \tilde{t}_{2c} - \beta H^2 = \frac{b_2^2}{2B}$$
(23)

происходит фазовый переход первого рода со скачками волнового числа и поляризации

$$q_{Hc} = \frac{b_2}{B}, \quad P_{xc} = P_s - \Lambda \chi_{e0} b_2 / B,$$
 (24)

причем с увеличением поля намагниченность µ возрастает от некоторого конечного спонтанного значения, определяемого полем Дзялошинского. При этом должен иметь место эффект температурного гистерезиса, наблюдаемого на опыте [2]. Из (23) следует, что абсолютная температура этого перехода равна

$$\tilde{T}_{2Hc} = T_2 + \frac{\chi_{e0}\Lambda^2}{2a} + \frac{\beta}{a}H^2 + \frac{b_2^2}{2aB}$$
(25)

и может эффективно повышаться благодаря перечисленным поправкам, делая спиральное состояние энергетически выгодным при более высокой температуре $T: T_f < T < \tilde{T}_{_{2Hc}} < T_1$ (рис. 2).

Подчеркнем, что, согласно (21), при наличии спонтанной поляризации $P_s = (-t_1/b_1)^{1/2}$ ниже температуры $T_1 \equiv T_{FE}$ поляризация P_x приобретает отрицательную поправку p_H , если $H > H_{th}$. Магнитный момент µ, возникающий в таком магнитном поле одновременно с поляризацией $|p_H|$, т.е. малой поправкой к спонтанной поляризации, возрастает с увеличением H согласно (22) (рис. 2). Эти изменения величин p_H и µ происходят в од-

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 56 № 4 2011

ном и том же температурном интервале $T_f < T < \tilde{T}_{2Hc}$, причем он расширяется с увеличением H, согласно (25), (рис. 2). С понижением температуры при фиксированном магнитном поле величины p_H и μ вместе с волновым числом Q_H увеличиваются по абсолютной величине, согласно (21) и (22), если $\tilde{t}_{2H} < 0$, но обращаются в нуль при $T \approx T_f$ (рис. 2). Вне указанного интервала температур имеем $Q_H = 0$, и магнитоэлектрические эффекты соответственно отсутствуют. Эксперимент [2] наглядно свидетельствует о перечисленных фактах.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Приложение внешнего электрического поля E вдоль оси x должно приводить к увеличению поляризации $P_{x,E}$, т.е. к уменьшению |p| в рассмотренном температурном интервале. Соответственно средний магнитный момент μ слабого ферромагнитного состояния в присутствии магнитного поля $H > H_{th}$ вдоль оси z и электрического поля E вдоль оси x должен уменьшаться благодаря увеличению P_x , т.е. уменьшению поправки |p|.

Представляет интерес температурное поведение электрической восприимчивости в слабом электрическом поле при существовании спиральной структуры и слабого ферромагнитного состояния. Поправку $\delta P(E, H)$ можно оценить с помощью выражения (19), в котором добавлено слагаемое $-\delta PE$, а $P_x \approx P_s + p_H + \delta P(E, H)$. Разложение по малой величине δP показывает, что при появлении спиральной модуляции и слабого ферромагнетизма величина δP есть

$$\delta P \approx \frac{E}{\left[-2t_1 + (\Lambda \chi_{e0})^{-2}(-\tilde{t}_{2H} + BQ_H^2)\right]},$$
 (26)

где $Q_H = -p_H (\Lambda_{Hc} \chi_{e0})^{-1}$, а p_H определяется выражением (21). Это придает электрической восприимчивости $\chi_e = \delta P/E$ своеобразное температурное поведение: появление модуляции может резко изменить стандартное поведение χ_e при понижении температуры, а именно: ниже точки \tilde{T}_{2Hc} восприимчивость претерпевает скачкообразное снижение (рис. 3). В точке $\tilde{t}_{2Hc} = \frac{b_2^2}{2B}$, в которой $q_{Hc} = \frac{b_2}{B}$, восприимчивость

$$\chi_{ec} \approx \frac{1}{\left[-2t_1 + (\Lambda \chi_{e0})^{-2} (b_2^2/2B)\right]}.$$
(27)

Поведение восприимчивости (или диэлектрической константы ε_x), подобное (27), наблюдалось на опыте [2].



Рис. 3. Качественная температурная зависимость диэлектрической восприимчивости χ_e . Условно, для сравнения с результатами [2], показано скачкообразное понижение χ_e ниже температуры \tilde{T}_{2He} .

выводы

Рассмотренные материалы манганиты обладают ют электрической поляризацией, эффективно перестраиваемой приложенным магнитным полем, т.е. они являются перспективными мультиферроиками [13, 14]. Несмотря на то что величина магнитоэлектрического эффекта в [2] все же не была "колоссальной", в [1] выражается надежда, что его аналогия с колоссальным эффектом магнитосопротивления [15] может привести к большой величине магнитоэлектрического эффекта в подходящих материалах и к контролю мультиферроидных доменов. При этом отмечалась все большая роль появляющегося слабого ферромагнетизма.

В настоящей работе с помощью феноменологического разложения по малым поправкам к спонтанной поляризации и малому волновому вектору спиральной структуры показано, что магнитоэлектрический эффект возникает при приложении магнитного поля определенной величины. Знаки константы спин-орбитального взаимодействия и волнового числа спирали взаимосвязаны. Спиральная магнитная структура и слабый ферромагнетизм образуются неизбежно одновременно в результате фазового перехода первого рода при критической температуре, меньшей температуры сегнетоэлектрического перехода, но большей температуры замерзания в стеклообразное состояние. Такая критическая температура зависит от магнитного поля, повышаясь с его увеличением, так что область эффекта расширяется с возрастанием магнитного поля (рис. 2). В пределах этой области температур магнитный момент быстро возрастает, а поправка к электрической поляризации является отрицательной независимо от знака константы спин-орбитального взаимодействия и также быстро увеличивается по абсолютной величине с ростом магнитного поля выше его порогового значения

(рис. 2). Диэлектрическая проницаемость скачкообразно уменьшается при указанной критической температуре (рис. 3). Эти изменения непосредственно связаны с быстрым ростом волнового числа спирали при уменьшении температуры ниже точки фазового перехода.

Фактически пороговое магнитное поле является триггером, запускающим все наблюдаемые эффекты, которые описываются единым образом. Все эффекты исчезают с приближением к температуре стеклования. Поэтому пороговое поле должно быть также достаточно велико, чтобы оно давало значение точки перехода, которое было бы больше температуры замерзания. В отсутствие магнитного поля температура гипотетического перехода, видимо, ниже этой температуры.

Константа спин-орбитального взаимодействия задает конкретное значение и направление волнового вектора спирали спинов, а при смене знака этой константы изменяется знак спирали (левой или правой), но поправка к спонтанной поляризации остается противоположной по отношению к последней. Очень слабая константа ведет к хаотичности поправок поляризации по их знаку, так что в этом случае поляризация в среднем равна спонтанной сегнетоэлектрической поляризации.

Как всякое феноменологическое рассмотрение, предложенное верно при малости всех указанных поправок. Однако можно думать, что качественно полученные результаты пригодны и при росте волнового числа, и при увеличении поправок к поляризации до достаточно больших значений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Argyriou D.N. // Physics. 2010. V. 3. P. 72.
- Choi Y.J., Zhang C.L., Lee N. et al. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105. P. 097201.
- 3. Dzyaloshinskii I. // Sov. Phys. JETP. 1964. V. 19. P. 960.
- 4. Moriya T. // Phys. Rev. Lett. 1960. V. 4. P. 228.
- 5. Cheong S.-W., Mostovoy M. // Nature Mater. 2007. V. 6. P. 13.
- 6. *Kenzelmann M., Harris A.B., Jonas S. et al.* // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 95. P. 087206.
- 7. Sergienko I.A., Dagotto E. // Phys. Rev. B. 2006. V. 73. P. 094434.
- Katsura H., Nagaosa N., Balatsky V. // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 95. P. 057205.
- 9. Van Aken B.B., Palstra T.T.M., Filippetti A. et al. // Nature Mater. 2004. V. 3. P. 164.
- Fennie C.J., Rabe K.M. // Phys. Rev. B. 2005. V. 72. P. 100103.
- 11. Звездин А.К., Пятаков А.П. // УФН. 2004. Т. 174. С. 465.
- 12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. // Электродинамика сплошных сред. М.: Физматлит, 2005. 656 с.
- 13. *Kimura T., Goto T., Shintani H. et al.* // Nature. 2003. V. 426. P. 55.
- 14. Goto T., Kimura T., Lawes G. et al. // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 92. P. 257201.
- 15. Imada M., Fujimori A., Tokura Y. // Rev. Mod. Phys. 1998. V. 70. P. 1039.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 56 № 4 2011